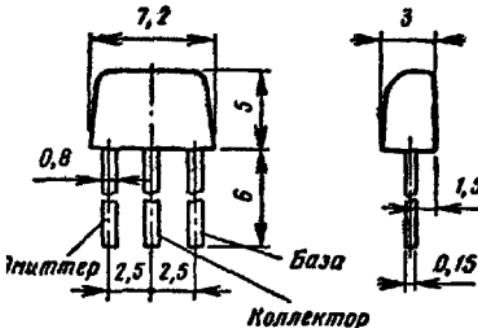


КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е

КТ361 (A-E)



Транзисторы кремниевые эпиконтактно-плоскостные структуры $p-n-p$ усиленные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB} = 10$ В, $I_B = 1$ мА:

$T = +25^{\circ}\text{C}$:

КТ361А, КТ361Д	20...90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	50...350
КТ361В	40...160

$T = +100^{\circ}\text{C}$:

КТ361А, КТ361Д	20...250
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	50...500
КТ361В	20...300

$T = -60^{\circ}\text{C}$:

КТ361А, КТ361Д	10...90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е	15...350
КТ361В	10...160

Аналогичная частота коэффициента передачи тока при $U_{KB} = 10$ В, $I_B = 5$ мА, не менее постоянной времени цепи обратной связи при $U_{KB} = 10$ В, $I_B = 5$ мА, $f = 5$ МГц, не более:

КТ361А, КТ361Б, КТ361Г	500 пс
КТ361В, КТ361Е	1000 пс
КТ361Д	250 пс

Границный ток коллектора при $U_{KB} = 10$ В, не более:

$T = +25$ и -60°C	1 мкА
$T = +100^{\circ}\text{C}$	25 мкА

Границный ток коллектор — эмиттер при $R_{ce} = 10$ кОм, $U_{ce} = U_{KB, \text{ макс}}$, не более:

КТ361А, КТ361Б	1 мкА
КТ361В, КТ361Д, КТ361Е	9 пФ
КТ361Д	7 пФ

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — эмиттер при $R_{ce} = 10$ кОм:

$T \leq +35^{\circ}\text{C}$:

КТ361А	25 В
КТ361Б	20 В
КТ361В, КТ361Д	40 В
КТ361Г, КТ361Е	35 В

$T = +100^{\circ}\text{C}$:

КТ361А	20 В
КТ361Б	15 В
КТ361В, КТ361Д	35 В
КТ361Г, КТ361Е	30 В

Постоянное напряжение база — эмиттер

Постоянный ток коллектора

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹

при $T \leq +35^{\circ}\text{C}$	150 мВт
при $T = +100^{\circ}\text{C}$	30 мВт

Температура $p-n$ перехода

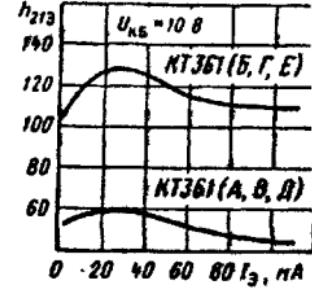
Температура окружающей среды

	+120 °C
	-60...+100 °C

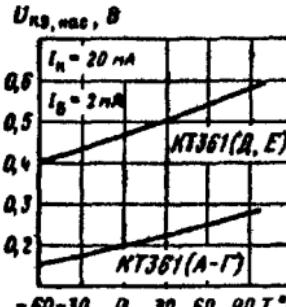
¹ В диапазоне температур +35...+100 °C допустимые значения рассеиваемой мощности и напряжения коллектор — эмиттер снижаются линейно.

Допускается трехкратный изгиб выводов не ближе 2 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм

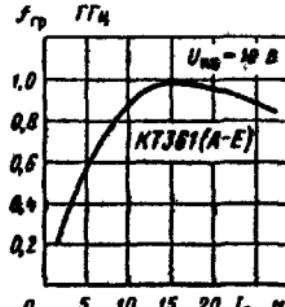
Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 2 мм.



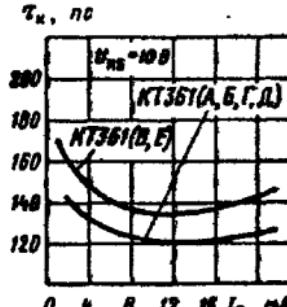
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от температуры



Зависимость граничной частоты от тока эмиттера



Зависимости постоянной времени цепи обратной связи от тока эмиттера